

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS001FY(单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-A5-05
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XS001FY 封装的成品管主要用于低压整流电路上。

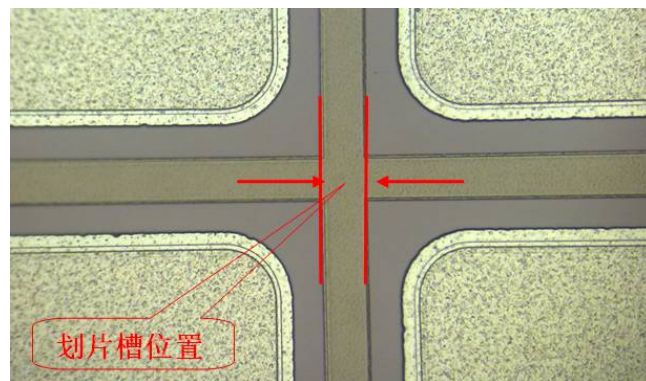
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 高电导性
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.63 mm×0.63 mm
			24.80 mil×24.80
	芯片厚度 (μm) (推荐)		220±20um
	划片道*尺寸 (μm)		40
	键合区面积 (μm ²)	正面	460×460
		背面电极 (阴极) (推荐)	
	正面电极 (阳极)	表层金属	银
		厚度	6.5±1.0
	背面电极 (阴极) (推荐)	表层金属	银
		厚度	1.4±0.2
硅片直径 (mm)		φ 125	
装片要求 (推荐)		焊料	

* 划片道位置示意图:



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	60	V	推荐封装形式: D0-214AC 推荐成品型号: SBLS0165AG
正向电流	I_D	0.5	A	
结温	T_j	110	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS001FY(单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-A5-05
		页码	2/2

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\ \mu\text{A}$	60	—	—	V
反向电流	I_{R2}	$V_{R2}=60\text{V}$	—	6	100	μA
正向电压	V_{F1}	$I_{F1}=0.5\text{A}$	—	0.51	0.6	V

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532